

specificazioni	
Numero di parte	RQ5A030APTL
fabbricante	LAPIS Semiconductor
Descrizione	MOSFET P-CH 12V 3A TSMT3
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	6332 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	1V @ 1mA
Vgs (Max)	-8V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TSMT3
Serie	-
Rds On (max) a Id, Vgs	62 mOhm @ 3A, 4.5V
Dissipazione di potenza (max)	1W (Ta)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	SC-96
temperatura di esercizio	150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	2000pF @ 6V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V
Tipo FET	P-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Tensione drain-source (Vdss)	12V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	3A (Ta)

   RQ5C020TPTR ROHM RQ5C020TPTR ROHM	   RQ5A025ZP ROHM RQ5A025ZP ROHM	   RQ5A030AP MOS ROHM ROHM SOT-23	   RQ5A030AP ROHM RQ5A030AP ROHM
   RQ5A040ZPTR ROHM RQ5A040ZPTR ROHM	   RQ5C020PTL ROHM ROHM SMD	   RQ5A020ZPTR ROHM RQ5A020ZPTR ROHM	   RQ5A040ZP ROHM RQ5A040ZP ROHM

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited